

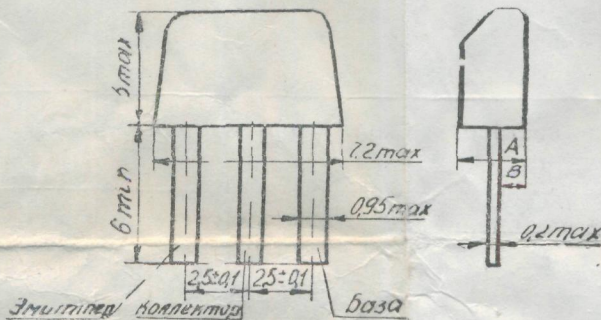


ЭТИКЕТКА

ТРАНЗИСТОРЫ ТИПОВ КТ315А, КТ315Б, КТ315Н, КТ315В, КТ315Г, КТ315Д, КТ315Е, КТ315Ж, КТ315И СООТВЕТСТВУЮТ ГОСТ 11630-70 И ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ ЖКЗ.365.200.ТУ



Габаритный чертеж с указанием расположения выводов



$A = 3 \text{ мм макс}$
 $B = \frac{A}{2} \pm 0,4 \text{ мм.}$

где А действительный размер.

Масса не более 0,18

СОДЕРЖАНИЕ ДРАГМЕТАЛЛОВ В ОДНОМ ТРАНЗИСТОРЕ

«Золото - 00640 мг»

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ при $t_{amb} = +25 \pm 10^\circ\text{C}$

Тип транзистора	Наименование параметра, режим измерения, единица измерения	Буквенное обозначение	Норма	
			не менее	не более
	Обратный ток коллектор-эмиттер, мА			
КТ315А	($I_c = 25\text{В}$, $R_{EB} = 10 \text{ кОм}$)	I_{CER}	—	0,6
КТ315Б, Н	$I_c = 20\text{В}$ »		—	0,6
КТ315В	$I_c = 40\text{В}$ »		—	0,6
КТ315Г	$I_c = 35\text{В}$ »		—	0,6
КТ315Д	$I_c = 40\text{В}$ »		—	1,0
КТ315Е	$I_c = 35\text{В}$ »		—	1,0
КТ315Ж	$I_c = 20\text{В}$, $R_{EB} = 0$	I_{CES}	—	0,01
КТ315И	$I_c = 60\text{В}$ »		—	0,1
КТ315А, Б, Ж, И	Граничное напряжение биполярного транзистора, В ($I_E = 5\text{мА}$)	$U_{(L)CEO}$	15	—
КТ315В, Д, Е			30	—
КТ315Г, Е			25	—
КТ315А, Б, В	Обратный ток эмиттера, мкА, ($I_E = 5\text{В}$)	I_{EBO}	—	30
КТ315Г, Д, Е				
КТ315Ж, Н				
КТ315И			—	50
КТ315А, В	Статический коэффициент передачи тока биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером ($I_c = 10\text{В}$, $I_E = 1\text{мА}$)	h_{21E}	30	120
КТ315Б, Г, Е, Н			50	350
КТ315Д			20	90
КТ315Ж			30	250
КТ315И			30	—

Тип транзистора	Наименование параметра, режим измерения, единица измерения	Буквенное обозначение	Норма	
			не менее	не более
КТ315А, Б, В, Г, Н	Обратный ток коллектора, мкА ($I_B = 10В$)	I_{CBO}	—	0,5
КТ315Д, Е, Ж, И			—	0,6
КТ315А, Б, В, Г	Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, В ($I_C = 20 мА, I_B = 2мА$)	U_{CESA1}	—	0,4
КТ315Д, Е			—	0,6
КТ315Ж			—	0,5
КТ315И			—	0,9
КТ315Н			—	0,4
КТ315А, Б, В, Г, Н	Напряжение насыщения база-эмиттер, В $I_C = 20мА, I_B = 2мА$	U_{BESA1}	—	1,0
КТ315Д, Е			—	1,1
КТ315Ж			—	0,9
КТ315И			—	1,35
КТ315А, Б, В, Г, Н	Модуль коэффициента передачи тока биполярного транзистора на высокой частоте $I_C = 10В, I_E = 5мА, f = 20МГц$	h_{21e}	12,5	—
КТ315Д, Е, Ж, И			—	—
КТ315А	Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте биполярного транзистора, пс ($I_C = 10В, I_E = 5мА$)	τ_c	—	300
КТ315Б, В, Г, Н			—	500
КТ315Д, Е			—	1000
КТ315Ж			—	800
КТ315И			—	950
КТ315А, Б, В	Емкость коллекторного перехода, пФ ($I_C = 10В, f = 5МГц$)	C_c	—	7,0
КТ315Д, Е, Н			—	10,0
КТ315Ж, И			—	—

Примечание. Транзистор КТ315Н по высшей категории качества не аттестован.

Штамп ОТК

